

C. Materials Growth & Characterization 분과

Room F

창의관 (B114)

일 시 : 2월 17일(금) 15:30-16:45

세션명 : [FF4-C] Nanostructured Electronics

좌 장 : 박진섭(한양대학교), 김문덕(충남대학교)

-
- FF4-C-1 15:30-16:00 **[Invited]** Characterization of RTN (Random Telegraph Noise) in Semiconductor Devices
저자: Nam-Hoon Kim, Sung-Min Joe, Ju-Wan Lee, and Jong-Ho Lee
소속: Electrical Engineering and Computer Science and Inter-University Semiconductor Research Center (ISRC), Seoul National University
- FF4-C-2 16:00-16:15 **Diamond Shape eSiGe Source/Drain for High Performance Sub-28nm PMOSFET**
저자: Hoi Sung Chung, Myung Sun Kim, Dong Hyuk Kim, Geo Myung Shin, Yong Ju Lee, Yu Bin Kim, Dong Suk Shin, Moon Han Park, Ja Hum Ku, and Nae-In Lee
소속: System LSI Division, Samsung Electronics Co., Ltd.
- FF4-C-3 16:15-16:30 **3차원 원자탐침 전자현미경을 이용한 Si 기판에 패터닝된 Fin구조 내 도핑 원소분석**
저자: 김보화¹, 박성민¹, 구길호¹, 박윤백³, 박찬경^{1,2}
소속: ¹포항공과대학교 신소재공학과, ²나노기술직접센터(NCNT), ³하이닉스 연구소 R&D기반기술그룹 분석개발팀
- FF4-C-4 16:30-16:45 **Morphology Controlled Growth of 1D Si Nanostructures by Exploiting Nanoscale Surface Diffusion for Anti-reflector**
저자: J. Yi and W. I. Park
소속: Department of Material Science & Engineering, Hanyang University